

CJD44H11 NPN
CJD45H11 PNP

**SURFACE MOUNT
COMPLEMENTARY SILICON
POWER TRANSISTORS**

DPAK
POWER!



DPAK TRANSISTOR CASE



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CJD44H11, CJD45H11 types are Complementary Silicon Power Transistors manufactured in a surface mount package designed for switching and power amplifier applications.

MARKING: FULL PART NUMBER

MAXIMUM RATINGS: ($T_C=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Collector-Emitter Voltage
Emitter-Base Voltage
Continuous Collector Current
Peak Collector Current
Power Dissipation
Power Dissipation ($T_A=25^\circ\text{C}$)
Operating and Storage Junction Temperature
Thermal Resistance
Thermal Resistance

SYMBOL

V_{CEO} 80
 V_{EBO} 5.0
 I_C 8.0
 I_{CM} 16
 P_D 20
 P_D 1.75
 T_J, T_{stg} -65 to +150
 θ_{JC} 6.25
 θ_{JA} 71.4

UNITS

V
V
A
A
W
W
 $^\circ\text{C}$
 $^\circ\text{C/W}$
 $^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_C=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
I_{CES}	$V_{CE}=80\text{V}$			10	μA
I_{EBO}	$V_{EB}=5.0\text{V}$			50	μA
BV_{CEO}	$I_C=30\text{mA}$	80			V
$V_{CE(SAT)}$	$I_C=8.0\text{A}, I_B=400\text{mA}$			1.0	V
$V_{BE(SAT)}$	$I_C=8.0\text{A}, I_B=800\text{mA}$			1.5	V
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=2.0\text{A}$	60			
h_{FE}	$V_{CE}=1.0\text{V}, I_C=4.0\text{A}$	40			
f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=500\text{mA}, f=20\text{MHz}$ (CJD44H11)		60		MHz
f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=500\text{mA}, f=20\text{MHz}$ (CJD45H11)		50		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=0.1\text{MHz}$ (CJD44H11)		120		pF
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=0.1\text{MHz}$ (CJD45H11)		220		pF
$t_d + t_r$	$I_C=5.0\text{A}, I_{B1}=500\text{mA}$ (CJD44H11)		320		ns
$t_d + t_r$	$I_C=5.0\text{A}, I_{B1}=500\text{mA}$ (CJD45H11)		150		ns
t_s	$I_C=5.0\text{A}, I_{B1}=I_{B2}=500\text{mA}$ (CJD44H11, CJD45H11)		450		ns
t_f	$I_C=5.0\text{A}, I_{B1}=I_{B2}=500\text{mA}$ (CJD44H11)		130		ns
t_f	$I_C=5.0\text{A}, I_{B1}=I_{B2}=500\text{mA}$ (CJD45H11)		100		ns

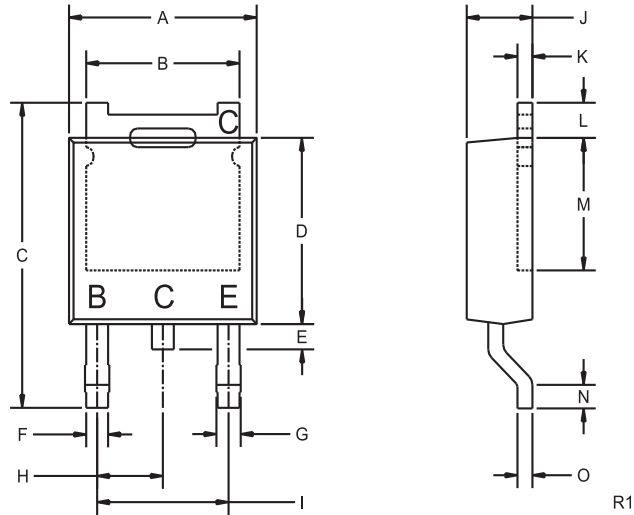
R2 (4-January 2010)

CJD44H11 NPN
CJD45H11 PNP

SURFACE MOUNT
COMPLEMENTARY SILICON
POWER TRANSISTORS



DPAK TRANSISTOR CASE - MECHANICAL OUTLINE



DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.250	0.265	6.35	6.73
B	0.205	0.215	5.21	5.46
C	0.374	0.409	9.50	10.40
D	0.235	0.245	5.97	6.22
E	0.025	0.040	0.64	1.02
F	0.025	0.035	0.64	0.88
G	0.030	0.045	0.76	1.14
H	0.090		2.28	
I	0.180		4.57	
J	0.086	0.094	2.19	2.38
K	0.018	0.023	0.46	0.58
L	0.040	0.050	1.02	1.27
M	0.170	-	4.32	-
N	0.020	-	0.51	-
O	0.018	0.023	0.46	0.58

LEAD CODE:

B) BASE
C) COLLECTOR
E) EMITTER
C) COLLECTOR

MARKING:

FULL PART NUMBER

DPAK TRANSISTOR (REV: R1)

R2 (4-January 2010)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9